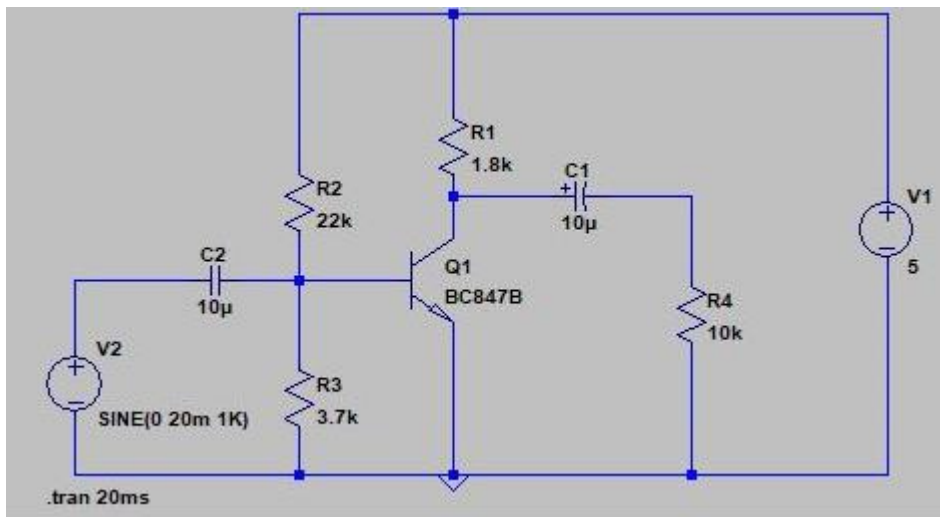


Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»
Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

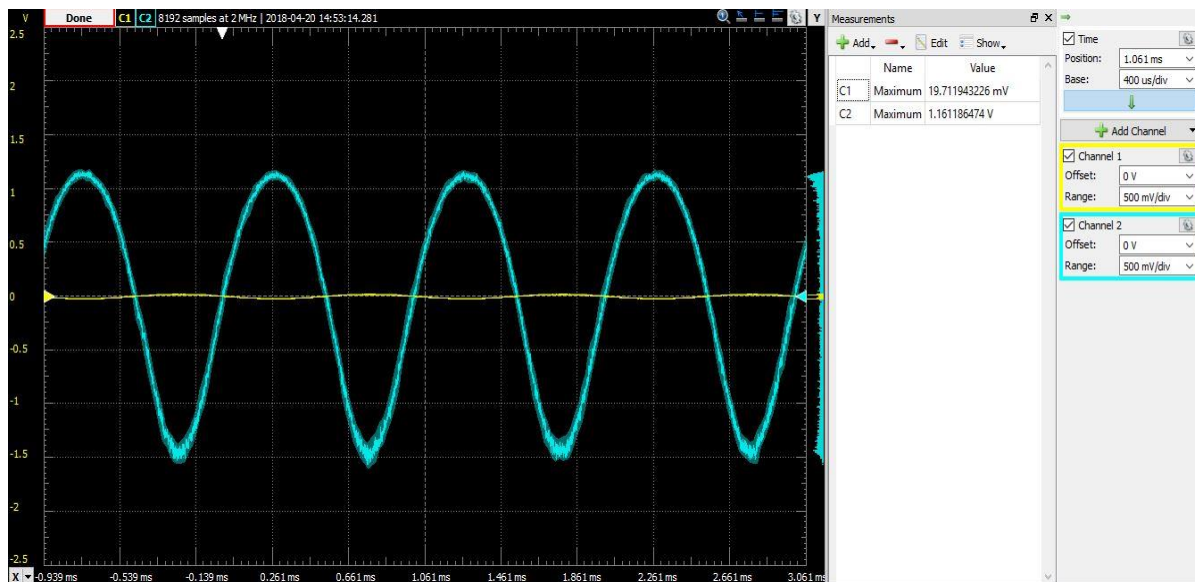
Звіт
З виконання лабораторної роботи №4
з дисципліни “Аналогова електроніка ”

Виконав:
студент групи ДК-62
Шашков А.В.
Перевірив:
доц. Короткий Є В.

1. Дослідження підсилювача на біполярному транзисторі з загальним емітером
 - а. Із виданих деталей було складено схему підсилювача з загальним емітером:
BC847B аналог kt315



Після підключення до входу генератору синусоїдальних коливань отримали такий сигнал:



Також було виміряно параметри робочої точки спокою підсилювача. Для цього генератор від'єднали та заміряли струми та напруги у схемі. Отримали такі дані:

$$U_{бс0} = 0,636 \text{ В}$$

$$I_{б0} = 8,3 \text{ мкА}$$

$$U_{кс0} = 2,5 \text{ В}$$

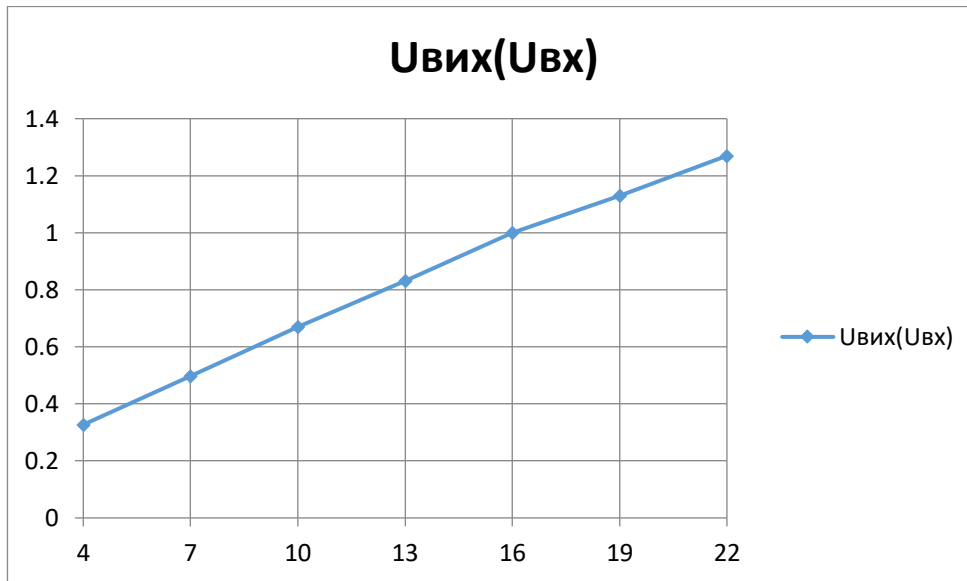
$$I_{к0} = 1,37 \text{ мА}$$

- б. Для вимірювання вхідного опору підсилювача генератор синусоїдального сигналу під'єднали до входу підсилювача через реостат. Напругу генератора виставили рівною 20мВ за допомогою осцилографа. Опір реостата регулювали до тих пір, поки на ньому не буде виділятися половина напруги генератора. Падіння напруги на реостаті заміряли двоканалним осцилографом. Наведені умови досягли при $R = 1965 \text{ Ом}$. Тому можна стверджувати, що $R_{вх} = 1965 \text{ Ом}$.
- с. Для вимірювання вихідного опору підсилювача скористувалися принципом еквівалентного генератора. Для цього від підсилювача відключили R_n та отримали на виході $U_{хх} = 500 \text{ мВ}$ при вхідній напрузі 10мВ. Потім до підсилювача під'єднали реостат та налаштували його опір так, щоб на ньому виділялося половина напруги холостого ходу. Такі умови було досягнені при опорі реостату 1650 Ом. Тому можна стверджувати, що $R_{вих} = 1650 \text{ Ом}$.
- д. Для вимірювання амплітудної характеристики підсилювача було знайдено максимальну вхідну напругу, що склала $U_{вх. \max} = 22\text{мВ}$. Після цієї напруги спостерігалися значні нелінійні спотворення. Далі було виміряно амплітуду вихідного сигналу при різних амплітудах вхідного сигналу, меншу за максимальну. Отримали такі дані:

$U_{вх}, \text{ мВ}$	$U_{вих}, \text{ мВ}$
4	327
7	496
10	670
13	832
16	1000
19	1130
22	1270

З отриманих даних побудували графік. З нахилу графіку було визначено

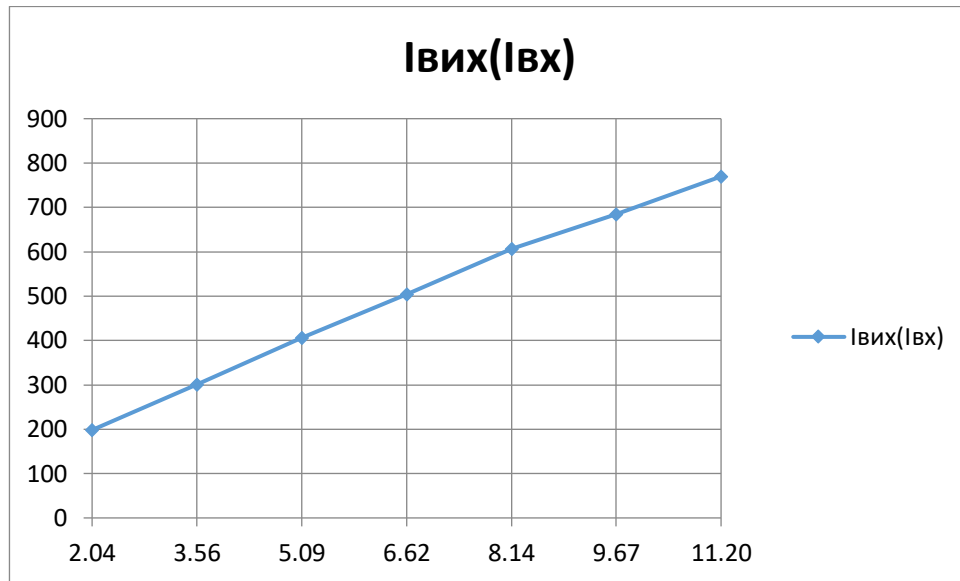
$$K_U \approx 55.$$



е. Для отриманих значень розраховали вихідний струм за законом Ома та вхідними та вихідними опорами, що були отримані раніше. Отримали такі дані:

I _{вх} , мкА	I _{вих} , мкА
4,15	198,1818
7,25	300,6061
10,36	406,0606
13,47	504,2424
16,58	606,0606
19,69	684,8485
22,80	769,697

З отриманих даних побудували графік. З нахилу графіку було визначено $K_I \approx 33$.



f. Для перевірки отриманих даних провели теоретичний розрахунок параметрів підсилювача:

$$g_m = \frac{I_{к0}}{\varphi_t} = \frac{1,37 * 10^{-3}}{25 * 10^{-3}} = 55 \text{ мС}$$

$$K_U = -g_m(R_k || R_H) = -0,055 * 1524 = -83,51$$

$$\beta = \frac{I_{к0}}{I_{60}} = \frac{1,37 * 10^{-3}}{8,3 * 10^{-6}} = 165$$

$$r_i = \frac{\beta}{g_m} = \frac{165}{0,055} = 3012 \text{ Ом}$$

$$R_{BX} = R_1 || R_2 || r_i = 2088 \text{ Ом}$$

$$K_I = K_U \frac{R_{BX}}{R_H} = 64,35 \frac{623}{12 * 10^3} = 17,37$$

Висновок: Було проведено дослідження роботи підсилювача на біполярному транзисторі з загальним емітером, експериментально досліджено його характеристики, такі як вхідний та вихідний опори, коефіцієнти підсилення за струмом та напругою. Звірівши експериментальні дані із розрахунками можна зробити висновки що з урахуванням деякої похибки експериментальні дані є вірними.